

<i>Ефимов В.П.</i> Фотопреобразователи энергии солнечного излучения нового поколения	100
<i>Лисовский В.А., Скубенко Е.В., Кравченко Е.А.</i> Экспериментальное исследование зажигания и горения разряда постоянного тока при различных диаметрах анода	116
<i>Береснев В.М., Погребняк А.Д., Соболев О.В., Грудницкий В.В., Турбин П.В., Колесников Д.А., Толмачева Г.Н.</i> Структура и свойства твердых покрытий систем (Ti-Zr-Si)N и (Ti-Hf-Si)N, полученных из потоков металлической плазмы	124
<i>Левенец В.В., Щур А.А., Широков Б.М.</i> Исследование состава и структуры пленок на основе Si-Ge сплавов ядерно-физическими методами анализа на пучках протонов	130
<i>Белоус В.А., Носов Г.И., Хороших В.М., Бородин О.В., Левенец В.В., Толмачева Г.Н., Холомеев М.Г.</i> Изменение твердости и модуля упругости поверхности сплава Э110 после облучения ионами металлов	138
<i>Лисовский В.А., Кравченко Е.А., Скубенко Е.В.</i> Экспериментальное исследование затрудненного тлеющего разряда постоянного тока в азоте	143
<i>Хороших В.М., Леонов С.А., Носов Г.И.</i> Влияние давления азота на процесс фокусировки потоков частиц, генерируемых вакуумным дуговым разрядом	150
<i>Покладок Н.Т.</i> Вплив магнітного поля на термодинамічні та кінетичні параметри формування і фізичні властивості інтеркалатів $Mn_x GaSe$	155
<i>Белоус В.А., Носов Г.И., Азаренков Н.А.</i> О влиянии облучения ионами Ag^+ на коррозионную стойкость металлов и сплавов	161
<i>Алиев Р., Мухтаров Э., Олимов Л.</i> Неразрушающий метод измерения глубины залегания p - n -перехода полупроводниковых фотоэлектрических структур	169
<i>Олимов Л.О.</i> Модель межзеренной границы в p - n -структурах на основе поликристаллических полупроводников	173
<i>Erdybaeva N.K.</i> Nano-microcomposite and combined coatings on Ti-Si-N/WC-Co-Cr/steel and Ti-Si-N/(Cr_3C_2) ₇₅ -(NiCr) ₂₅ base: their structure and properties	180
<i>Приходько Н.І.</i> Поняття фінансового стану підприємства: деякі аспекти його визначення	188
<i>Правила оформления рукописей</i>	191
<i>Правила оформлення рукописів</i>	192
<i>Information for authors</i>	193